2P035 グラファイト表面上のタングステンクラスターと超構造の STM 観測

(コンポン研¹・豊田工大²) 早川鉄一郎¹, 安松久登², 小泉真一¹, 近藤保²

【序】固体表面上にデポジットされたクラスターの物性や反応性は表面との相互作用によっ て変化し、同時にクラスター周囲の表面特性も変化することが期待される。我々はクラスタ ーと表面との相互作用を理解することを目的として、固体表面にデポジットしたクラスター および近傍表面の電子構造を調べている。本研究では、サイズ選別したタングステンクラス ター(W,)をグラファイト(0001)表面上にデポジットし、STM(走査型トンネル顕微鏡)観察 およびトンネル分光測定により、クラスターおよびその周囲に生じた超構造について調べた ので報告する。

【実験】タングステンクラスターイオンはマグネトロンスパッタ源を用いて生成し、四重極 質量フィルターによってサイズ選別した。グラファイト試料は空気中でへき開し、~10⁻⁸ Pa の真空中で Ar⁺ スパッタ(運動エネルギー 50 eV、入射量約 5×10¹⁰ ions/mm²)前処理した のち、その表面に並進運動エネルギー 10~100 eV、入射量約 2×10¹⁰ clusters/mm²で W_n⁺ を衝突させてデポジットした。前処理を行なっていない試料にはクラスターが安定に固定さ れなかった。前処理や W_n デポジションは室温で行った。クラスターをデポジットした表面 を超高真空中で STM 室に移送し、圧力 10⁻⁸ Pa 以下、温度 77 K において STM 観察および トンネル分光測定を行った。

【結果】STM で観測した単位面積当たりのクラスター数は、入射クラスターイオン量から 推算される数と同程度であった。また、STM くり返しスキャンによって STM 像が変化し ないことから、クラスターはグラファイト表面に安定に固定されていると結論できる。図1 にグラファイト表面上に衝突エネルギー 30 eV でデポジットされた W₁₀の STM 像を示す。 直径約1 nm の W₁₀が中心部に見られ、その周囲直径約8 nm の領域には、グラファイト格 子間隔よりも周期の大きな超構造が明瞭に現れている。図1の A-B 断面のプロファイルを



図1: グラファイト(0001)表面に デポジットされた W₁₀の STM 像



図 2 :図 1 の A-B 断面の高さ プロファイル (*d* はグラファイト原子列間隔)

図2に示す。超構造の周期はグラファイト原子列間隔の2倍になっている。このクラスターの中心および清浄なグラファイト表面で測定したトンネルスペクトルを図3(a)、図3(b)にそれぞれ示す。グラフ横軸は試料バイアス V、グラフ縦軸はトンネル電流 Iの微分 dI/dV で、電子状態密度に強く関連した量である。清浄なグラファイトのスペクトルが V = 0を中心とした放物線的な形状をしているのに対して、クラスター中心でのスペクトルでは V = 0を挟んだ約 0.6 V の領域で dI/dV = 0 となっている。さらにこのクラスターから約4 nm 離れた位置で測定したトンネルスペクトルにも同様な特徴が見られた。

【考察】クラスター周囲に見られた超構造は、図2に示した周期などから(3×3)R30° 超構造であると結論される。この超構造は、グラファイト表面のステップや欠陥、吸着分子 などによって散乱された伝導電子の干渉により生じるものであると報告されている(G.M. Shedd and P.E. Russell, Surf. Sci. <u>266</u> (1992) 259.など)。本実験で観測された超構造はク ラスターが散乱中心になって生成していると考えられる。この超構造の観測された領域(直 径約 8 nm)はこれまで報告されているものと比べて2倍程度広いことから、クラスターに よる散乱強度は非常に大きいと推測される。一方、クラスター中心でのトンネルスペクトル から、クラスターの電子構造には約 0.6 eV の HOMO-LUMO ギャップが存在すると考えら れる。また、クラスターの周囲 数 nm の範囲でもバンドギャップが存在していることがト ンネルスペクトルから明らかになった。この結果は、この領域でグラファイト表面が非金属 的になっていることを示している。

